

Oxydes transparents conducteurs (TCO).

Partie I :

- 1) $a = b \neq c$ et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- 2) \star 8 S_{n^+} au sommet du cube + 1 S_{n^+} au centre
 $\rightarrow N_{S_{n^+}} = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
 - \star 2 O à l'intérieur du cube + 4 O sur les faces.
 $\rightarrow N_O = 2 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$
 - \star 2 groupements $S_{n^+}O_2$ par maille.
- 3) Il y'a 2 S_{n^+} dans cette maille :
 S_{n^+a} (0; 0; 0) à l'origine de la maille
 S_{n^+b} ($\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$) au centre de la maille.
- 4) \star L'intensité diffractée par un plan (h, k, l) dépend du facteur de structure : $I_{hkl} = |F_{hkl}|^2$
 - \star $F_{hkl} = \sum_c^{\text{atomes}} f_i e^{2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)}$ avec $f_i =$ facteur de forme atomique.
 - \star $f_i \sim z_i \Rightarrow I_{hkl} \sim z_i^2$
 - \star $\left(\frac{z_{S_{n^+}}}{z_O}\right)^2 = \left(\frac{50}{8}\right)^2 = 39$ (si on prend les charges
 $\left(\frac{z_{S_{n^+}^{4+}}}{z_{O^{2-}}}\right)^2 = \left(\frac{46}{10}\right)^2 = 21$)

\Rightarrow Parce que la densité électronique est beaucoup plus grande sur S_n que 0, les S_n contribuent plus à la diffraction des RX.

$$\begin{aligned}
 5) \quad F_{hkl} &= \sum_i^{S_n} f_{S_n} e^{2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)} + \sum_j^0 f_0 e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)} \\
 &= f_{S_n} \left(e^{2\pi i(hx_0 + ky_0 + lz_0)} + e^{2\pi i(h \times \frac{1}{2} + k \times \frac{1}{2} + l \times \frac{1}{2})} \right) \\
 &= f_{S_n} (1 + e^{i(k+h+l)})
 \end{aligned}$$

$F_{hkl} = 0$ si $k+h+l$ est impair

$F_{hkl} \neq 0$ si $k+h+l$ est pair.

6) * Oui, tous les pics correspondent à $k+h+l$ pair sauf le pic (111).

* Pour ce dernier, qui est peu intense, on peut penser qu'il vient des oxygènes dont nous avons négligé la contribution.

7) Il faut déterminer 2 paramètres de maille: a et c .

* Il faut utiliser la loi de Bragg: $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$.

* Il faut prendre les pics ayant les indices les plus simples.

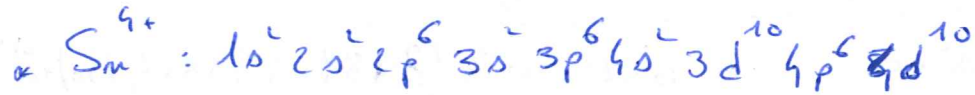
* Pour a : (200) $\rightarrow 2\theta \approx 38^\circ$

$$d_{200} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{1,542}{2 \sin(\frac{38}{2})} = 2,368 \text{ \AA}$$

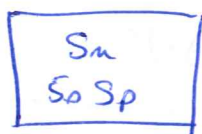
$$d_{200} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2^2}{a^2} + \frac{0^2}{b} + \frac{0^2}{c}}} = \frac{a}{2} \Rightarrow a = 2d_{200} = 4,736 \text{ \AA}$$

Partie II

11) Le niveau de Fermi ne coupe aucune bande
 \Rightarrow isolant.

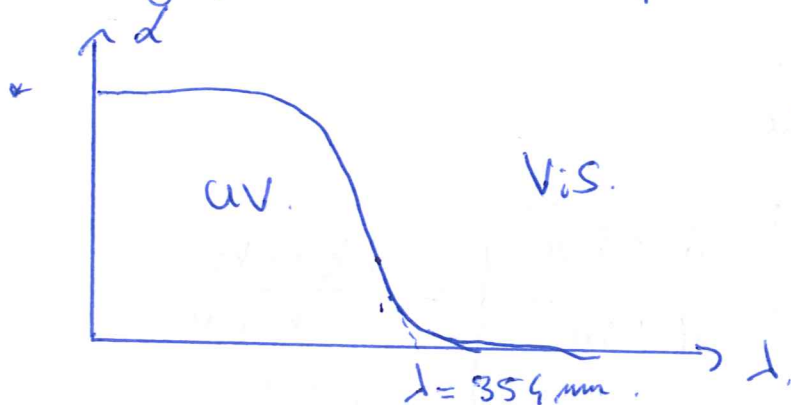


↳ Dernière bande remplie sur O (orbitales 2p)
première bande vide sur Sn (orbitales 5s, 5p)



E_g

13) Le gap est direct au point Γ et il vaut $\approx 3,5$ eV.



\Rightarrow si poudre : SnO_2 blanc
si monocristal : SnO_2 incolore.

• Pour c : $(00c) \rightarrow 2\theta = 58^\circ$

$$d_{00c} = \frac{1,542}{2 \sin\left(\frac{58}{2}\right)} = 1,590 \text{ \AA}$$

$$c = 2 \times d_{00c} = 3,181 \text{ \AA}$$

$$8) \rho_{\text{SnO}_2} = \frac{N_{\text{SnO}_2} \times M_{\text{SnO}_2}}{N_A \times a^2 \times c} = \frac{2 \times (118,71 + 16 \times 2)}{6,02 \times 10^{23} \times (3,181 \times 4,736 \times 4,736) \times 10^{-24}}$$

$$= 7,01 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

9) La distance de entre oxygène de l'étain central est :

$$d_{\text{Sn}-\text{O}} = \sqrt{(x_{\text{Sn}} - x_{\text{O}})^2 a^2 + (y_{\text{Sn}} - y_{\text{O}})^2 b^2 + (z_{\text{Sn}} - z_{\text{O}})^2 c^2}$$

$$= \sqrt{(0,5 - 0,31)^2 \times 4,736^2 + (0,5 - 0,31)^2 \times 4,736^2 + (0,5 - 0)^2 \times 3,181^2}$$

$$= 2,037 \text{ \AA}$$

$$d_{\text{Sn}-\text{O}} = R_{\text{Sn}} + R_{\text{O}} \rightarrow R_{\text{Sn}} = 2,037 - 1,26 = 0,777 \text{ \AA} = 78 \text{ pm}$$

10) Compacité : $\sigma = \frac{V_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}}$

$$V_{\text{O}} = \frac{4}{3} \pi R_{\text{O}}^3 = \frac{4}{3} \pi \times 1,26^3 = 8,38 \text{ \AA}^3$$

$$V_{\text{Sn}} = \frac{4}{3} \pi R_{\text{Sn}}^3 = \frac{4}{3} \pi \times 0,78^3 = 1,93 \text{ \AA}^3$$

$$V_{\text{maille}} = a^2 c = 3,181 \times 4,736^2 = 71,35 \text{ \AA}^3$$

$$\sigma = \frac{4 V_{\text{O}} + 2 V_{\text{Sn}}}{V_{\text{maille}}} = 0,53$$

\rightarrow structure peu compacte

14) Le chemin $\Gamma \rightarrow X$ correspond à la direction (100)

$$\Gamma = (0, 0, 0) \text{ et } X = \left(\frac{\pi}{a}, 0, 0\right)$$

Le chemin $\Gamma \rightarrow Z$ correspond à la direction (001)

$$\Gamma (0, 0, 0) \text{ et } Z = \left(0, 0, \frac{\pi}{c}\right)$$

Comme $a > c$ alors $\frac{\pi}{a} < \frac{\pi}{c}$ donc la distance

$\Gamma - X$ est plus petite que la distance $\Gamma - Z$.

15) * Si on dope la bande de conduction : dopage n
→ ce sont les e^- qui conduisent.

* Si on dope la BV, dopage p
→ ce sont les h^+ qui conduisent.

16) * Pour les e^- , c'est la BC qu'il faut prendre en compte. $E(k) = E_0 + \frac{\hbar^2}{2m_e^*} k^2$

$$= 5,8 \cdot 10^{-19} + 2,7 \cdot 10^{-38} k^2$$

$$\Rightarrow m_e^* = \frac{\hbar^2}{2 \times 2,7 \cdot 10^{-38}}$$

$$\underline{AN} : m_e^* = \frac{(1,05 \cdot 10^{-34})^2}{2 \times 2,7 \cdot 10^{-38}} = 2,02 \cdot 10^{-31} \text{ kg.}$$

$$m_e^* = \frac{2,02 \cdot 10^{-31}}{9 \cdot 10^{-31}} = 0,23 m_e.$$

* Pour m_h^* , on fait le \tilde{m} calcul sur la BV:

$$m_h^* = \frac{A^2}{2 \times 3,1 \cdot 10^{33}} = \frac{(1,05 \cdot 10^{-34})^2}{2 \times 3,1 \cdot 10^{33}} = 1,62 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

$$m_h^* = 1,78 m_e$$

* $m_e^* \ll m_h^* \rightarrow \text{SiO}_2$ sera un meilleur conducteur de type n que de type p.

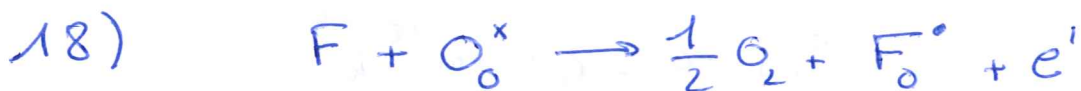
\hookrightarrow il faut faire un dopage n: ajouter des e^- dans la BC.

17) $\sim m^* \propto \frac{1}{\beta}$ β : intégrale de résonance.

$\beta_{s_0, s_p} \gg \beta_{z_p}$ car s_0, s_p plus diffusives que z_p .

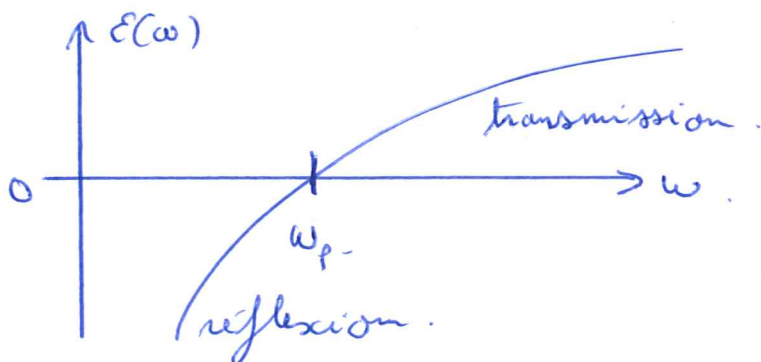
$$\Rightarrow m_{s_0, s_p}^* = m_e^* \ll m_h^* = m_{z_p}^*$$

Partie III



19) $\rightarrow 1e^-$ est libéré dans le matériau
 \rightarrow il va dans la BC \rightarrow dopage de type n.

20) si $\epsilon(\omega) < 0 \rightarrow$ réflexion de la lumière.
 si $\epsilon(\omega) > 0 \rightarrow$ transmission de la lumière.



$$\epsilon(\omega_p) = 0$$

$$\Rightarrow n = \frac{\epsilon_0 m^* \omega_p^2}{e^2}$$

$$\text{or } \omega_p = \frac{2\pi c}{\lambda_p}$$

$$\Rightarrow n = \frac{\epsilon_0 m^*}{e^2} \times \frac{4\pi^2 c^2}{\lambda_p^2}$$

$$AN : n = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \times 0,23 \times 9,1 \cdot 10^{-31} \times 4\pi^2 \times (3 \cdot 10^8)^4}{(1,602 \cdot 10^{-19})^2 \times (800 \cdot 10^{-9})^2}$$

$$= 4 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3} = 4 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3}$$

21) Sachant que $1 e^-$ est généré par $1 F$ cela signifie que :

$$[F] = n = 4 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$$

$$= \frac{N_F}{V_{\text{maille}}}$$

$$N_F = 4 \cdot 10^{26} \times (4,736 \times 4,736 \times 3,181) \cdot 10^{-30} = 0,029$$

Il y'a en moyenne 0,029 atomes de F par maille.

22) Dans une maille il y'a 4 O, si en moyenne 0,029 O est remplacé par 1F, alors il y'a 3,971 O

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 \text{ Sn} \\ 3,971 \text{ O} \\ 0,029 \text{ F} \end{cases} \text{ par maille} \Rightarrow \text{Sn}_{1,9855} \text{F}_{0,0145}$$

$$\Rightarrow \frac{N_F}{N_O} = \frac{0,029}{4} = 0,725\%$$

23) Dès que SnO_2 est dopé, il devient métallique.

$$\Rightarrow \rho \uparrow \text{ si } T \uparrow$$

Cela correspond au comportement observé.

24) A T fixée, $\rho \downarrow$ si le dopage \uparrow , or

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_e} \quad n \uparrow \text{ si le dopage } \uparrow$$

\Rightarrow c'est bien le comportement attendu.

25) graphiquement: $\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{2 \cdot 10^5} = 5 \cdot 10^4 \Omega \cdot m^{-1}$

26) $\sigma = n e \mu_e \Rightarrow \mu_e = \frac{\sigma}{n e}$

$\alpha = 3\% \rightarrow \frac{N_F}{4} = 0,03 \rightarrow N_F = 0,12 / \text{maille}$

$\Rightarrow n = \frac{0,12}{(4,736 \times 4,736 \times 3,181) \cdot 10^{-30}} = 1,68 \cdot 10^{27} m^{-3}$

$\mu_e = \frac{5 \cdot 10^4}{1,602 \cdot 10^{-19} \times 1,68 \cdot 10^{27}} = 1,86 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot C^{-1} \cdot \Omega^{-1}$

27)

| | σ $\Omega \cdot m^{-1}$ | n m^{-3} | μ_e $m^2 \cdot \Omega^{-1} \cdot C^{-1}$ |
|------|-----------------------------------|----------------------|---|
| 0,5% | $2 \cdot 10^4$ | $2,80 \cdot 10^{26}$ | $4,46 \cdot 10^{-4}$ |
| 3% | $5 \cdot 10^4$ | $1,68 \cdot 10^{27}$ | $1,86 \cdot 10^{-4}$ |
| 7% | 10^5 | $3,92 \cdot 10^{27}$ | $1,59 \cdot 10^{-4}$ |

\rightarrow transparent

} réfléchissant.

28) On voit que $\mu_e \downarrow$ si $n \uparrow$.

En effet: $\mu_e = e \frac{\tau}{m^*}$ τ : temps de collision.

si $n \uparrow$, le nbre de défauts $\uparrow \Rightarrow$ beaucoup de collision

$\Rightarrow \tau \downarrow$

$\Rightarrow \mu_e \downarrow$

En conclusion: $\sigma = n e \mu_e$

si $[F] \uparrow \rightarrow n \uparrow \rightarrow \mu_e \downarrow \Rightarrow \sigma \uparrow$

29) Note W , la f° de travail correspond à l'énergie minimum à fournir à un matériau afin d'en extraire un e^- pour l'amener à l'énergie du vide.

30) Dans un solide : $W = |E_f|$

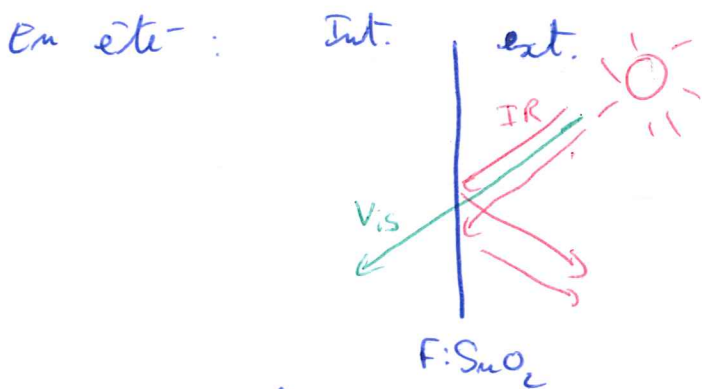
• Pour SnO_2 pure $E_f \approx -6,2 \text{ eV} \rightarrow W = 6,2 \text{ eV}$.

(cf Figure 3)

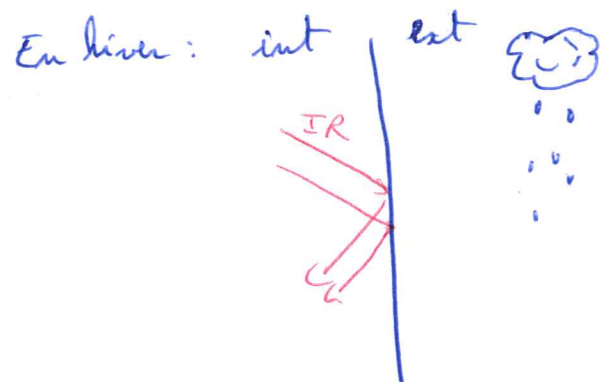
• Pour $\text{SnO}_2 : \text{F}$, E_f est proche de la BC :

$|E_f| \approx 4,5 \text{ eV}$.

31) • F : SnO_2 laisse passer la lumière visible mais réfléchit les IR.



laisse passer la lumière Vis.
réfléchit les IR.



''

